

**DEVICE AND METHOD FOR MOUNTING SEMICONDUCTOR DEVICE**

Publication number: JP11121517

Publication date: 1999-04-30

Inventor: KITO SHIGEFUMI; NISHIYAMA SHINZO; SASAKI HIROYASU; MOGI TOSHIYUKI; OMORI NOBORU; TAKANO EIJI

Applicant: HITACHI LTD; HITACHI SHONAN DENSHI

Classification:

- international: H01L21/60; H01L21/52; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/60; H01L21/52

- european:

Application number: JP19970276814 19971009

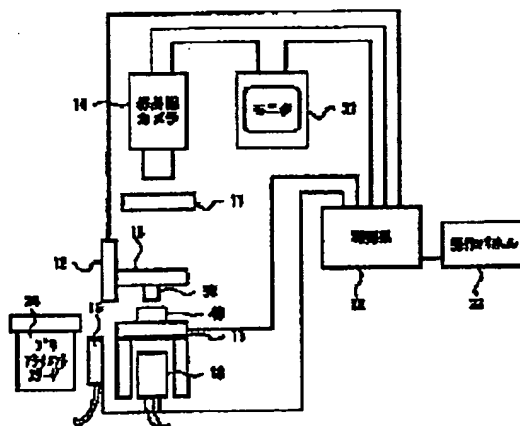
Priority number(s): JP19970276814 19971009

Report a data error here

**Abstract of JP11121517**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide mounting of semiconductor devices with high precision for positioning and with small position offset at heating and fixing.

**SOLUTION:** In a semiconductor device mounting device which mounts a semiconductor device through which infrared rays 30 are transmittable on an infrared-ray transmittable substrate 40, a substrate-mounting stage 11 for mounting the substrate 40 is provided. In addition, there are provided an infrared-ray transmitting image light source 15 which is provided in one of upper and lower directions of the stage 11, a transmitted image-recognizing camera 14 provided on the side opposite to a side, where an infrared-ray transmitted image light source 14 of the stage 11 is disposed, and a local heating condensing lens 16 for condensing and irradiating heating lights on the substrate 40.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

3/4

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-121517

(43) 公開日 平成11年(1999) 4月30日

(51) Int.Cl.<sup>4</sup>H 01 L 21/60  
21/52

識別記号

3 1 1

F I

H 01 L 21/60  
21/523 1 1 S  
C

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号

特願平9-276814

(22) 出願日

平成9年(1997)10月9日

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(71) 出願人 000233295

日立瀬南電子株式会社

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町393番地

(72) 発明者 鬼頭 繁文

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株

式会社日立製作所情報通信事業部内

(72) 発明者 西山 恒康

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株

式会社日立製作所情報通信事業部内

(74) 代理人 弁理士 沼形 義彰

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体素子搭載装置および搭載方法

(57) 【要約】

【課題】 高精度に位置合わせを行い、かつ加熱固定の際の位置ズレ量の小さい高精度な半導体素子搭載を提供する。

【解決手段】 赤外線透過可能な半導体素子30を赤外線透過可能な基板40上に搭載する半導体素子搭載装置100において、基板40を搭載する基板載置用ステージ11と、該ステージ11の上下方向のいずれか一方に設けた赤外線透過画像用光源15と、前記ステージ11の赤外線透過画像用光源14が配置された側と反対側に設けた透過画像認識用カメラ14と、加熱用光を集光して前記基板に照射する局部加熱用集光レンズ16とを設けた。

FP03-0042-00uS  
" 0042-01uS  
" 0044-00uS

" 0046-00uS  
" 0270-00uS  
" 0278-00uS

'06.10.03

OA JP

